

# Silicon-Diode

## **1S138**

800V / 200mA

# DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

1S130, 1S131, 1S132, 1S134, 1S136, 1S138

**Diffundierte-Siliziumdiode**

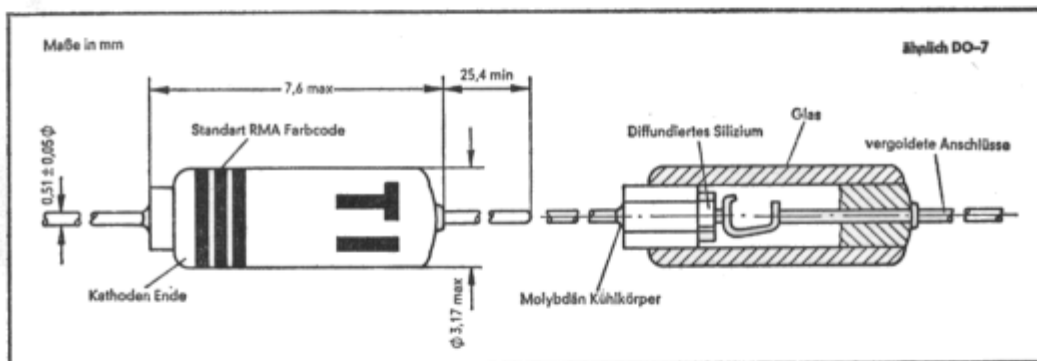
**Preiswerte und hochwertige diffundierte Silizium-Diode**  
**Ideal für kommerzielle Anwendung**  
**Axiale Drahtanschlüsse**

**Mechanische Daten**

Hermetisch geschlossenes Hartglasgehäuse.

Gewicht: etwa 0,2 g.

Die Gehäuseabmessungen entsprechen VASCA SO-7.

**Farbcode (beginnend von der Katodenseite)**

1S130	braun	orange	schwarz
1S131	braun	orange	braun
1S132	braun	orange	rot
1S134	braun	orange	gelb
1S136	braun	orange	blau
1S138	braun	orange	grau

**Absolute Grenzwerte**

	1S130	1S131	1S132	1S134	1S136	1S138	Einh.
Spitzensperrspannung von $-65\text{ °C}$ bis $+100\text{ °C}$	50	100	200	400	600	800	V
Richtstrom von $-65\text{ °C}$ bis $+25\text{ °C}$	200	200	200	200	200	200	mA
Richtstrom bei $100\text{ °C}$	100	100	100	100	100	100	mA
Periodischer Spitzenstrom bei $25\text{ °C}$	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	A
Periodischer Spitzenstrom bei $100\text{ °C}$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	A
* Stoßstrom 1 s bei 50 Hz und $25\text{ °C}$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	A
* Stoßstrom 1 s bei 50 Hz und $100\text{ °C}$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	A
Umgebungstemperatur	$-65\text{ °C}$ bis $+100\text{ °C}$						

\* Die Spannung muß am Ende der Impulsperiode abgeschaltet werden.  
Diode kann davor voll belastet werden.

**Absolute Grenzen**

Maximaler Reststrom bei Durchbruchspannung und $25\text{ °C}$ Umgebungstemperatur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	$\mu\text{A}$
Maximale Durchlaßspannung bei $I_F = 200\text{ mA}$ und $25\text{ °C}$ Umgebungstemperatur	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	V

**Typische Parameter**

	typ	max	Einh.
Reststrom bei Durchbruchspannung und $100\text{ °C}$ Umgebungstemperatur	10	50	$\mu\text{A}$
Durchlaßspannung bei $I_F = 1\text{ mA}$ und $25\text{ °C}$ Umgebungstemperatur	0,55	0,60	V

